

LM1972

LM1972 Pot 2-Channel 78dB Audio Attenuator with Mute



Literature Number: JAJ805

ご注意：この日本語データシートは参考資料として提供しており、内容が最新でない場合があります。
製品のご検討およびご採用に際しては、必ず最新の英文データシートをご確認ください。



April 1995

LM1972

μ Pot™ 2 チャンネル 78dB オーディオアッテネータ (ミュート機能付き)

概要

LM1972 は、デジタル制御型 2 チャンネル・78dB の CMOS オーディオ・アッテネータです。各チャンネルは、0dB ~ 47.5dB の範囲で 0.5dB ステップ、48dB ~ 78dB の範囲で 1.0dB ステップの減衰が可能であり、減衰量 104dB のミュート機能も内蔵しています。この対数減衰ステップは、アプリケーションに合わせてソフトウェアにより調整することができます。

μ Pot の性能は、その優れた S/N 比、極めて低い全高調波歪み + ノイズ (THD + N) として、高精度のチャンネル・セパレーション特性により実証されています。 μ Pot は、入力信号を出力信号から分離するミュート機能を備え、96dB 以上の減衰量が得られます。また、減衰量の設定を変更してもポップ音が生じることはありません。

LM1972 は TTL/CMOS コンパチブルの 3 線シリアル・インタフェースを介し、チャンネル選択用と減衰レベル設定用のデータを受信します。内蔵のデータ出力ピンを介して複数の μ Pot をデジチーチェーン接続することにより、アプリケーションに合わせてインネブル・ライン/データ・ライン数を削減することができます。

主な仕様

- 全高調波歪み + ノイズ 0.003% (最大)
- 周波数特性 100kHz (- 3dB) (最小)
- 減衰範囲 (ミュートを除く) 78dB (代表値)
- 減衰誤差 ± 0.25 dB (最大)
- SN 比 (4Vrms を基準) 110dB (最小)
- チャンネル・セパレーション 100dB (最小)

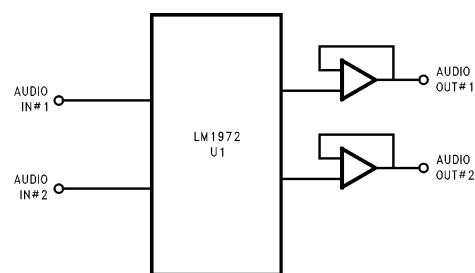
特長

- 3 線シリアル・インタフェース
- デジチーチェーン接続が可能
- 減衰量 104dB のミュート機能
- 減衰量変更によるポップ/クリック音を生じない

アプリケーション

- スタジオ用自動ミキシング・コンソール
- 音楽再生システム
- 音響効果システム
- 電子音楽 (MIDI)
- パーソナル・コンピュータによるオーディオ制御

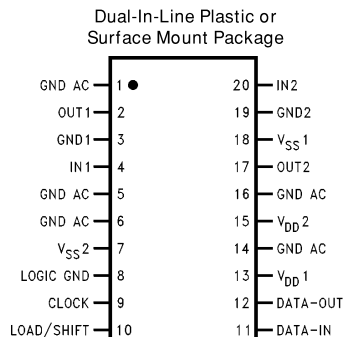
Typical Application



TL/H/11978-1

FIGURE 1. Typical Audio Attenuator Application Circuit

Connection Diagram



TL/H/11978-2

Top View

Order Number LM1972M or LM1972N
See NS Package Number M20B or N20A

μ Pot™ および Overture™ はナショナルセミコンダクター社の商標です。

絶対最大定格 (Note 1、2)

本データシートには軍用・航空宇宙用の規格は記載されていません。
関連する電氣的信頼性試験方法の規格を参照下さい。

電源電圧 ($V_{DD} - V_{SS}$)	15V
全てのピン電圧	$V_{SS} - 0.2V \sim V_{DD} + 0.2V$
消費電力 (Note 3)	150mW
ESD 耐圧 (Note 4)	2000V
接合部温度	150
ハンダ付け条件	
N パッケージ (10 秒)	+ 260
保存温度範囲	- 65 ~ + 150

動作条件 (Note 1、2)

温度範囲

T_{MIN} T_A T_{MAX}

電源電圧 ($V_{DD} - V_{SS}$)

0 T_A + 70
4.5V ~ 12V

電氣的特性 (Note 1、2)

特記のない限り、以下の規格値は $V_{DD} = +6V$, $V_{SS} = -6V$, $V_{IN} = 5.5V_{pk}$, $f = 1kHz$ の条件で全チャネルに対して適用されます。リミット値は $T_A = +25$ に対して適用され、デジタル入力は TTL/CMOS コンパチブルです。

Symbol	Parameter	Conditions	LM1972		Units (Limits)
			Typical (Note 5)	Limit (Note 6)	
I_S	Supply Current	Inputs are AC Grounded	2	4	mA (max)
THD+ N	Total Harmonic Distortion plus Noise	$V_{IN} = 0.5 V_{pk}$ @ 0dB Attenuation	0.0008	0.003	% (max)
XTalk	Crosstalk (Channel Separation)	0dB Attenuation for V_{IN} V_{CH} measured @ - 78dB	110	100	dB (min)
SNR	Signal-to-Noise Ratio	Inputs are AC Grounded @ - 12dB Attenuation A-Weighted	120	110	dB (min)
A_M	Mute Attenuation		104	96	dB (min)
	Attenuation Step Size Error	0dB to - 47.5dB - 48dB to - 78dB		± 0.05 ± 0.25	dB (max) dB (max)
	Absolute Attenuation Error	Attenuation @ 0dB	0.03	0.5	dB (min)
		Attenuation @ - 20dB	19.8	19.0	dB (min)
		Attenuation @ - 40dB	39.5	39.0	dB (min)
		Attenuation @ - 60dB	59.3	57.5	dB (min)
		Attenuation @ - 78dB	76.3	74.5	dB (min)
	Channel-to-Channel Attenuation Tracking Error	Attenuation @ 0dB, - 20dB, - 40dB, - 60dB		± 0.5	dB (max)
		Attenuation @ - 78dB		± 0.75	dB (max)
I_{LEAK}	Analog Input Leakage Current	Inputs are AC Grounded	10.0	100	nA (max)

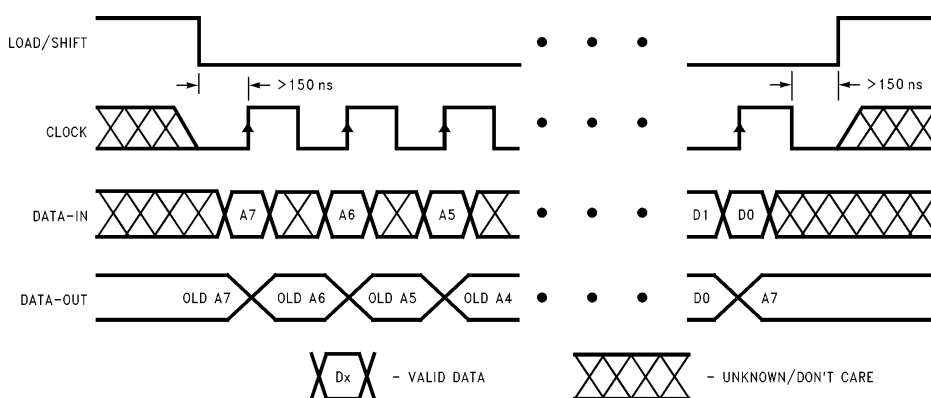


FIGURE 2. Timing Diagram

TL/ H/ 11978-3

電気的特性 (Note 1、2)(つづき)

特記のない限り、以下の規格値は $V_{DD} = +6V$ 、 $V_{SS} = -6V$ 、 $V_{IN} = 5.5V_{pk}$ 、 $f = 1kHz$ の条件で全チャネルに対して適用されます。リミット値は $T_A = +25$ に対して適用され、デジタル入力は TTL/CMOS コンパチブルです。

Symbol	Parameter	Conditions	LM1972		Units (Limits)
			Typical (Note 5)	Limit (Note 6)	
R_{IN}	AC Input Impedance	Pins 4, 20, $V_{IN} = 1.0 V_{pk}$, $f = 1 kHz$	40	20 60	k Ω (min) k Ω (max)
I_{IN}	Input Current	@ Pins 9, 10, 11 @ $0V < V_{IN} < 5V$	1.0	± 100	nA (max)
f_{CLK}	Clock Frequency		3	2	MHz (max)
V_{IH}	High-Level Input Voltage	@ Pins 9, 10, 11		2.0	V (min)
V_{IL}	Low-Level Input Voltage	@ Pins 9, 10, 11		0.8	V (max)
	Data-Out Levels (Pin 12)	$V_{DD} = 6V$, $V_{SS} = 0V$		0.1 5.9	V (max) V (min)

Note 1: 特記のない限り、全電圧は GND 端子 (1、3、5、6、14、16、19) を基準にして測定されます。

Note 2: 「絶対最大定格」とは、デバイスに破壊が発生する可能性のあるリミット値をいいます。「動作条件」とはデバイスが機能する条件を示しますが、特定の性能リミット値を保証するものではありません。「電気的特性」とは、特定の性能リミット値を保証する特別な試験条件での AC および DC の電気的仕様を示します。この場合、デバイスが「動作条件」の範囲にあるものとします。リミット値 (Limit) が記載されていないパラメータの仕様は保証されませんが、代表値 (Typical) はデバイス性能を示す目安になります。

Note 3: 温度上昇時の動作では、最大消費電力の定格を T_{JMAX} (最大接合部温度) θ_{JA} (接合部・周囲温度間熱抵抗) および T_A (周囲温度) に従って下げなければなりません。最大許容消費電力は $PD = (T_{JMAX} - T_A) / \theta_{JA}$ 、または絶対最大定格で示される値のうち、いずれか低い方の値です。LM1972 の場合、 T_{JMAX} は $+150$ 、基板実装時における θ_{JA} は $65 /W$ です。

Note 4: 使用した試験回路は、人体モデルに基づき、直列抵抗 $1.5k\Omega$ と $100pF$ のコンデンサから成る回路を使用し各端子に放電させます。

Note 5: 代表値 (Typical) は、 $T_A = +25$ で得られる最も標準的な値です。

Note 6: リミット値 (Limit) は、ナショナル セミコンダクター社の AOQL (平均出荷品質レベル) に基づき保証されます。

端子説明

信号グラウンド (3、19): 各入力専用の独立したグラウンド (GND1、GND2)。

信号入力 (4、20): 2 つの独立した信号入力ピン (IN1、IN2)。

信号出力 (2、17): 2 つの独立した信号出力ピン (OUT1、OUT2)。

電源 (13、15): 正電源ピン (V_{DD1} 、 V_{DD2})。

電源 (7、18): 負電源ピン (V_{SS1} 、 V_{SS2})。単一電源構成の場合はグラウンドに接続。

AC グラウンド (1、5、6、14、16): ダイに接続されていない (ワイヤボンディングされていない) ピン。隣接ピン間における信号のクロストークを防ぐために、これらのピンの AC 接地が必要です。例えば、ピン 14 をピン 13、ピン 15 にテカップリングすることで、配線が容易になり最良の信号絶縁が行えます。

ロジック・グラウンド (8): インタフェース・ライン (クロック、ロード / シフト、データ入力、データ出力) 用のデジタル信号グラウンド。

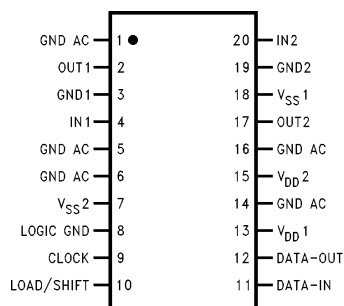
クロック (9): TTL/CMOS レベル・コンパチブルのクロック入力ピン。入力クロックの立上がりエッジで、このピンからデータが内部のシフトレジスタにロードされます。

ロード / シフト (10): TTL/CMOS レベル・コンパチブルのロード / シフト入力ピン。デバイスのイネーブル・ピンとして働き、この入力 Low レベル (0V) の間、クロックに同期してデータが取り込まれます。

データ入力 (11): TTL/CMOS レベル・コンパチブルのデータ入力ピン。マイクロ・コントローラからのシリアル・データはこのピンを介して取り込まれ、チャンネルの減衰レベルを変更するためにラッチ/デコードされます。

データ出力 (12): 同一データ・ラインで複数の μPot を制御するディジーチェーン・モード用ピン。マイクロ・コントローラからディジーチェーンにデータが入力されると、シフトレジスタ内の先行データはデータ出力ピンからチェーンの次段 μPot にシフトアウトされます (チェーンの最終 μPot であればグラウンドにシフトアウト)。ロード / シフト・ラインは、新しいデータがすべて個々のレジスタにシフトインした後に High にセットします。

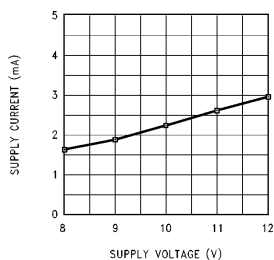
Connection Diagram



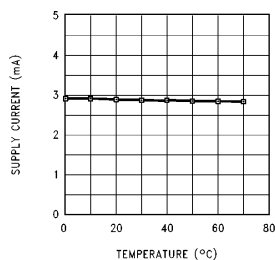
TL/H/11978-4

Typical Performance Characteristics

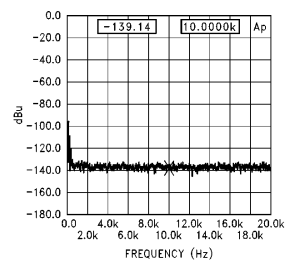
Supply Current vs
Supply Voltage



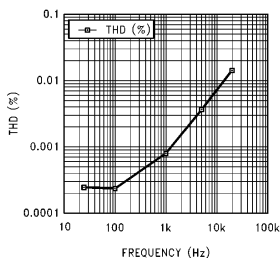
Supply Current vs
Temperature



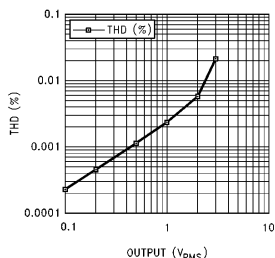
Noise Floor Spectrum by FFT
Amplitude vs Frequency



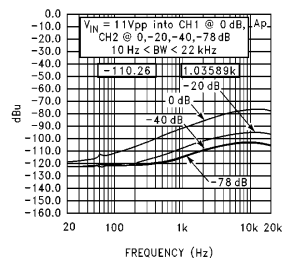
THD vs Freq by FFT
 $V_{DD} - V_{SS} = 12V$



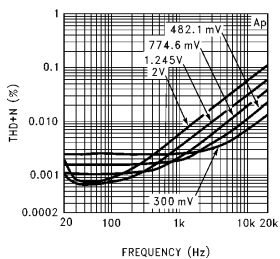
THD vs V_{OUT} at
1 KHz by FFT
 $V_{DD} - V_{SS} = 12V$



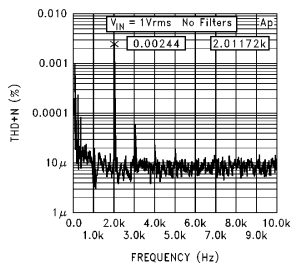
Crosstalk Test



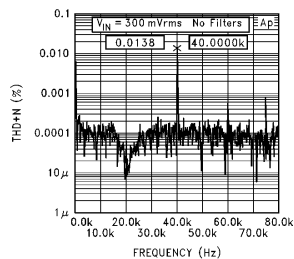
THD + N vs
Frequency and Amplitude



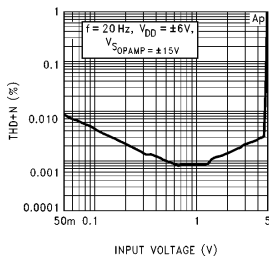
FFT of 1 kHz THD



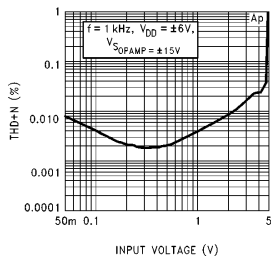
FFT of 20 kHz THD



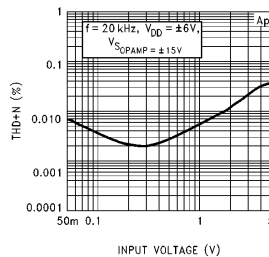
THD + N vs Amplitude



THD + N vs Amplitude



THD + N vs Amplitude



TL/H/11978-5

アプリケーション情報

減衰ステップの構成

Fig. 3 に LM1972 μ Pot の基本的な減衰ステップ特性曲線を示します。この減衰ステップは、アプリケーションに応じてソフトウェアで変更可能です。例えば、Fig. 4 に示すように、1dB 刻みの一定したステップ幅で対数的に減衰を行うことも可能です。減衰ステップをカスタマイズするうえで、各減衰レベル (dB) とデータ・ビット値を対応させることが必要となります (Table I 参照)。デバイスの減衰レベルは、チャンネル・アドレスが認識された場合に限り変更されます。チャンネル・アドレスが認識されると、Table I のデータ・ビットに対応する減衰レベルに変更されます。LM1972 は、モノラル信号を左右のチャンネルに分離するパンニング制御回路として構成することもできます (Fig. 6 参照)。この回路では LM1972 の基本的な減衰ステップを用いるか、Fig. 4 に示すように 1dB の一定したステップ幅で対数減衰を行うようにプログラムすることも可能です。

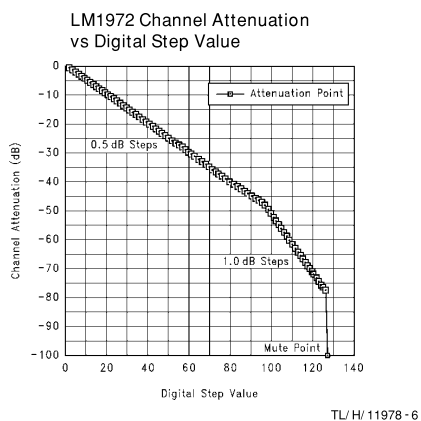


FIGURE 3. LM1972 Attenuation Step Scheme

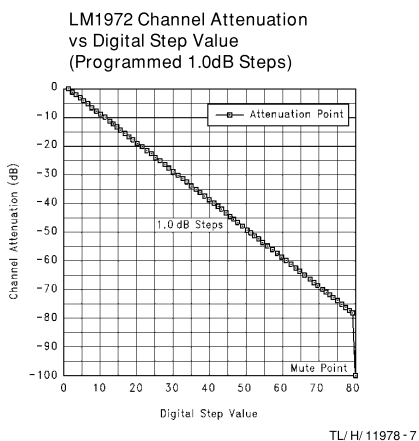


FIGURE 4. LM1972 1.0dB Attenuation Step Scheme

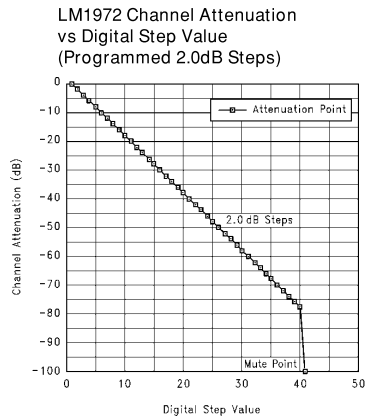


FIGURE 5. LM1972 2.0dB Attenuation Step Scheme

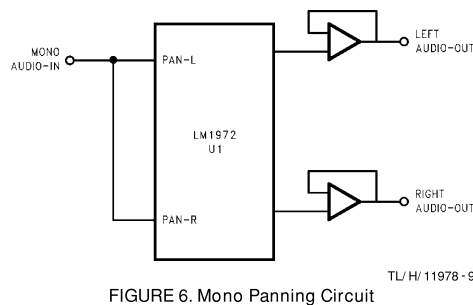


FIGURE 6. Mono Panning Circuit

入力インピーダンス

μ Pot の入力インピーダンスは、40k Ω (標準) で一定です。通常、不要な DC 成分がデバイス内に伝搬するのを防ぐために、1 μ F の入力カップリング・コンデンサを付加しますが、前段の DC オフセットが無視できる程度であれば、このコンデンサは必要ありません。ただし、高性能システムの場合は、入力カップリング・コンデンサの使用を推奨します。

出力インピーダンス

μ Pot の出力インピーダンスは通常、25k Ω ~ 35k Ω の範囲で減衰ステップの変化とともに非線形的に変化します。これは、 μ Pot が対数的な減衰特性をもつ抵抗ラダー・ネットワーク回路から構成されているためです。したがって、 μ Pot は線形的なポテンショメータとしてではなく、対数アッテネータとしてみなすことができます。

μ Pot の直線性の測定にはバッファが必要です。これは、ほとんどの測定システムの場合、入力インピーダンスが高くなく、必要な測定精度が得られないためです。測定システムの入力インピーダンスが低いと、 μ Pot の出力に負荷がかかり、測定結果は不正確になります。こうした負荷の影響を防ぐために、バッファ/アンプとして JFET 入力オペアンプを使用して下さい。この場合、 μ Pot の性能は、外付けのバッファ/アンプの性能にのみ影響されます。

アプリケーション情報(つづき)

ミュート機能

μ Pot の大きな特長の一つは、入力信号を 104dB 減衰するミュート機能を内蔵していることです (Fig. 3 参照)。これは、出力を入力から物理的に切り離すと同時に、約 2k Ω の抵抗を介して出力ピンを接地することで実現しています。

ミュート機能は、デバイスの電源投入時に、または、0111 1111 ~ 1111 1111 までのバイナリ・データがデバイスにシリアル転送された時に実行されます。これらのバイナリ・データが送られると、デバイスはそれまで設定されていた減衰動作からミュート動作に移行します。したがって、ミュート・ボタンをシステムに装備すれば、そのボタンを押すことにより、マイクロ・コントローラから μ Pot に該当データを送り、一方のチャネルまたは両チャネルをミュートさせることが可能になります。この機能はソフトウェアで行うため、システム構成において大幅な柔軟性が得られます。

DC 入力

μ Pot はオーディオ帯域信号用のアッテネータとして設計されていますが、入力 DC 電圧のトラッキングも可能です。このデバイスでは、各電源電圧から 1 ダイオード・ドロップ分までの DC 電圧をトラッキングすることができます。

μ Pot の出力段にバッファを用いた場合、DC トラッキングの能力は μ Pot の出力バッファのゲイン構成と電源電圧によって決まることに注意して下さい。さらに、出力バッファの電源電圧は μ Pot の電源電圧と同じにする必要がなく、電源電圧を上げて DC トラッキングの能力を高めることも可能です。

シリアルデータ・フォーマット

LM1972 は、マイクロ・コントローラによる制御が容易な 3 線式のシリアル・インタフェースを採用しています。Fig. 2 に、その 3 線信号 (データ入力、クロック、ロード/シフト) のタイミング図を示します。Fig. 8 のブロック図は、デジタル・インタフェースを介してタップ・スイッチを制御し、所定の減衰レベルを選択する構成を示しています。Fig. 2 のタイミング図に示されるように、ロード/シフト・ラインは、最初のクロック・パルスの立ち上がりエッジよりも最低 150ns 前に Low にし、16 データ・ビットのすべてが転送されるまで Low 状態に保持する必要があります。シリアル・データはチャネル選択用の 8 ビットと、それに続く減衰量設定用の 8 ビットから構成され、いずれも最初に MSB から転送します。8 ビットの減衰量設定データに先き立ち、8 ビットのアドレス・データを転送します。Fig. 7 にシリアル・データ・フォーマットの転送プロセスを示します。

TABLE I. LM1972 Micropot Attenuator Register Set Description

MSB	LSB
Address Register (Byte 0)	
0000 0000	Channel 1
0000 0001	Channel 2
0000 0010	Channel 3
Data Register (Byte 1)	
Contents	Attenuation Level dB
0000 0000	0.0
0000 0001	0.5
0000 0010	1.0
0000 0011	1.5
::: ::	::
0001 1110	15.0
0001 1111	15.5
0010 0000	16.0
0010 0001	16.5
0010 0010	17.0
::: ::	::
0101 1110	47.0
0101 1111	47.5
0110 0000	48.0
0110 0001	49.0
0110 0010	50.0
::: ::	::
0111 1100	76.0
0111 1101	77.0
0111 1110	78.0
0111 1111	100.0 (Mute)
1000 0000	100.0 (Mute)
::: ::	::
1111 1110	100.0 (Mute)
1111 1111	100.0 (Mute)

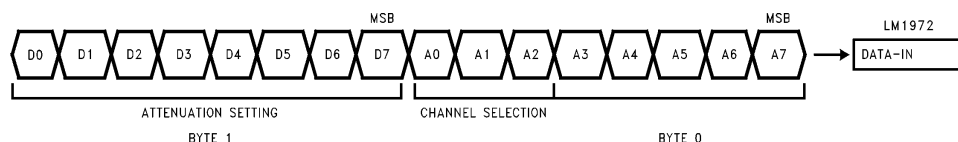


FIGURE 7. Serial Data Format Transfer Process

TL/H/11978-10

アプリケーション情報(つづき)

μPot のシステム・アーキテクチャ

μPot のデジタル・インタフェースは本質的にはシフトレジスタであり、このインタフェースを介し、シリアル・データのシフトイン、ラッチ、デコードが行われます。新しいデータがデータ入力ピンにシフトインされると、それより前のデータはデータ出力ピンからシフトアウトされます。データのシフトイン後に、ロード/シフトラインが High になり、新たなデータがラッチされます。次に、このデータはデコードされ、該当するタップ・スイッチが切り替わり、選択されたチャネルは任意の減衰レベルに設定されます。このプロセスは、減衰量を変更する毎に繰り返されます。なお、各チャネルの減衰レベルは、アッテネーションを変更するためにチャネルを選択した時、または μPot をパワーダウンして再度電源投入した時に限り更新されます。μPot を電源投入した時は、各チャネルともミュート・モードになります。

μPot のラダー・アーキテクチャ

μPot の各チャネルは、それぞれ独立した抵抗ラダー・ネットワーク回路により構成されています。Fig. 9 に示すように、このラダー回路は複数の R1/R2 抵抗素子から構成されており、減衰レベルの設定に使用されます。各素子に内蔵されている複数のタップ・スイッチにより、Table 1 のデータ・ビットに対応する減衰レベルが選択されます。Fig. 9 のラダー回路からわかるように、チャネルの入力インピーダンスは選択されたタップ・スイッチに関係なく一定ですが、出力インピーダンスは選択されたタップ・スイッチによって変動します。

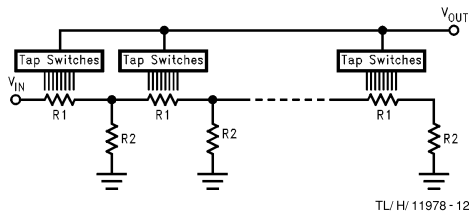


FIGURE 9. μPot Ladder Architecture

デジタル・ラインの信号レベル

μPot のデジタル・インタフェース部は、シフトレジスタの入力がダイオード・ドロップ分(約 1.4V)のスレッショルド電圧で動作するため、TTL または CMOS ロジック・コンパチブルとなっています。

デジタルデータ出力ピン

複数の μPot のデータ出力ピンを使用し、デジタイゼーションのシステム構成にすることができます。デジタイゼーション構成では、各チャネル当たりデータラインとロード/シフトラインがそれぞれ 1 本だけで済むため、プリント基板の配線パターンを簡素化できます。

データ出力ピンを使用しない場合はチャネル間の分離を確実にし、信号ラインにデジタル・ノイズが乗らないように、2kΩ の抵抗を介してデータ出力ピンを終端して下さい。このピンをフローティング状態にしておくこともできますが、データ出力ラインの信号ノイズが隣接ラインに乗ってノイズ特性が悪化することがあります。

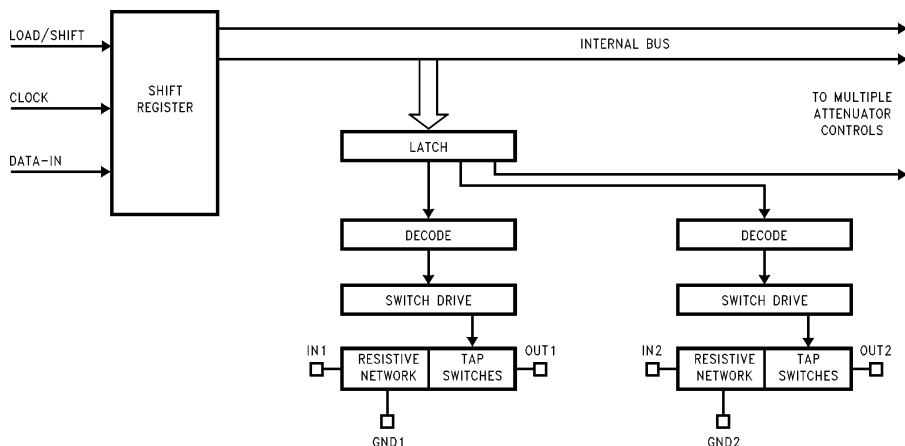


FIGURE 8. μPot System Architecture

TL/H/11978-11

アプリケーション情報(つづき)

デジチチェーン機能

μ Pot のデジタル・インタフェースは基本的にシフトレジスタですから、同じデータ・ラインとロード/シフト・ラインで複数の μ Pot をプログラムすることができます。Fig. 10 に示すように、 n 個の μ Pot をデジチチェーンで接続する場合、 $16n$ ビットがシフト、ロードされます。データのロード手順は、 μ Pot が 1 個の時と同じです。まず、ロード/シフト・ラインが Low になり、続いてデータがクロックに同期して順番に取り込まれ、同時に各 μ Pot にある先行データがデータ出力ピンからチェーンの後続 μ Pot にシフトアウトされて行きます(チェーンの最終 μ Pot ではグラウンドにシフトアウト)。その後、ロード/シフト・ラインが High になり、データはそれぞれ対応する μ Pot にラッチされます。データはアドレスに従ってデコードされ(チャンネルの選択)、減衰レベルの制御を行うタップ・スイッチが選択されます。

クロストークの測定

μ Pot のクロストーク(“Typical Performance Characteristics”の項を参照)は、片側チャンネルに信号を入力し、他チャンネルの同一周波数の出力レベルを測定して求めたものです。正確なクロストークを求めるためには、同じ周波数の信号レベルで測定することが重要です。また、測定精度を上げるために、 $1\mu\text{F}$ のコンデンサを介して測定チャンネル入力の AC 接地が必要です。

クリック/ポップの防止

ここでは、3 つの理由から出力バッファの必要性について説明します。これらの理由はシステム上すべて重要です。

第 1 に、 μ Pot の出力段にバッファ/アンプを付加することで、デバイスの減衰ステップ変更により生じる可聴クリック/ポップを確実に防止することができます。出力段にオンボードのバイポーラ・オペアンプを使用している場合、 μ Pot の出力インピーダンスの変化時に、このオペアンプの動作に一定量の DC バイアス電流が必要となり、DC 電圧の“ポップ”が発生します。すなわち、 μ Pot の出力インピーダンスが減衰ステップの変化に伴って変化すると、バイポーラ・アンプ動作に一定量の DC バイアス電流が必要になり、このポップ現象が起こります。DC 電圧の“ポップ”は出力インピーダンスが変化すると、DC バイアス電流も変化するため発生します。

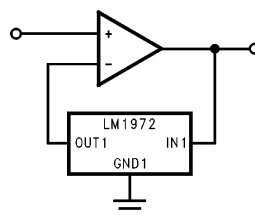
第 2 に、 μ Pot にドライブ機能がないため、バッファ/非反転アンプによりゲインを獲得しなければなりません。

第 3 に、 μ Pot の出力を高インピーダンスにし、負荷がかかるのと直線性誤差が生じるのを防ぐ必要があるためです。JFET 入力バッファを使用すれば、 μ Pot の出力段に高入力インピーダンスが得られるので、こうした問題は生じません。

クリックとポップは、LF412ACN などの JFET 入力バッファ/アンプを使用することで防止することができます。LF412 は高入力インピーダンスだけでなく、オーディオ帯域における低ノイズ・フロア、低 THD + N を特長としているため、システムでの信号状態と直線性を確保することができます。この方法では、システム全体の性能は JFET 入力バッファ/アンプの品質と性能によって決まります。

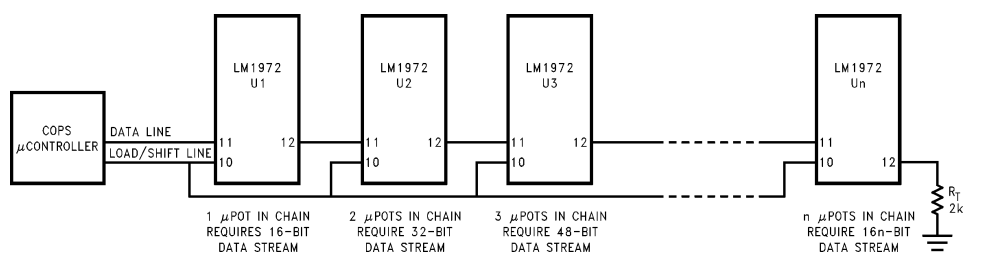
対数ゲイン・アンプ

μ Pot はアンプの帰還ループで使用することもできますが、この場合も、前述したように μ Pot の出力を高インピーダンスにし、その高精度の性能と直線性を確保する必要があります。同様に、出力に負荷がかかると減衰量の値も変化します。対数ゲイン・アンプを形成する場合は、Fig. 11 に示すように μ Pot を用いて帰還ループを構成します。この構成では、Table 1 に示した減衰レベルがゲイン・レベルとなり、最大 78dB の増幅が可能です。ほとんどのアプリケーションでは、ゲインを 78dB にすると信号クリッピングを生じますが、 μ Pot はプログラミングによりゲインの調整を行い、システムのクリッピング・レベルを回避することができます。なお、ミュート・モードでは、入力が出力から分離されることに注意して下さい。この構成でミュート・モードにすると、アンプがオープン・ループ・ゲイン状態になり、コンパレータの動作になります。こうした回路のプログラミングと設計には細心の注意が必要です。最大限の性能を得るためには、JFET 入力アンプを使用して下さい。



TL/H/11978-14

FIGURE 11. Digitally-Controlled Logarithmic Gain Amplifier Circuit

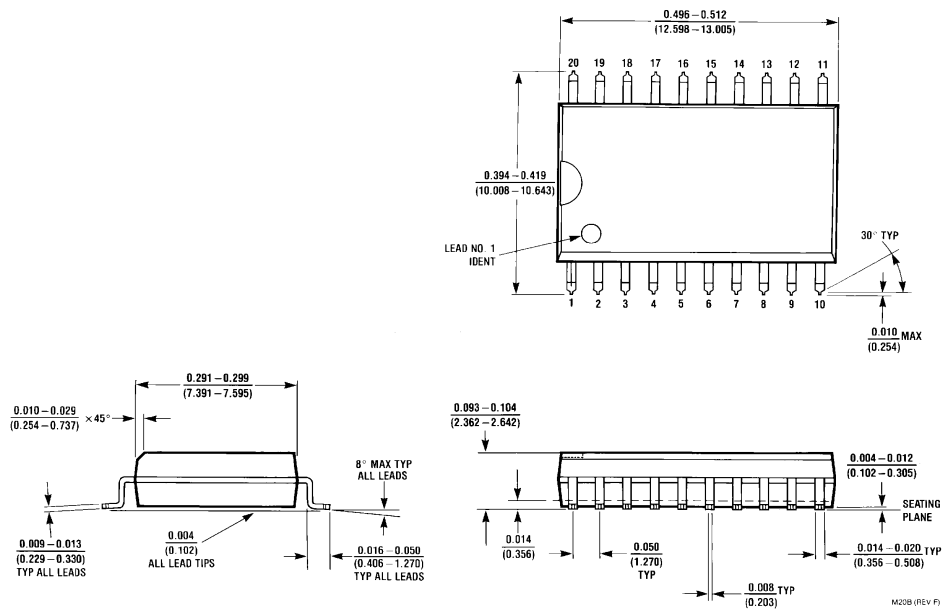


TL/H/11978-13

FIGURE 10. n- μ Pot Daisy-Chained Circuit

NOTE

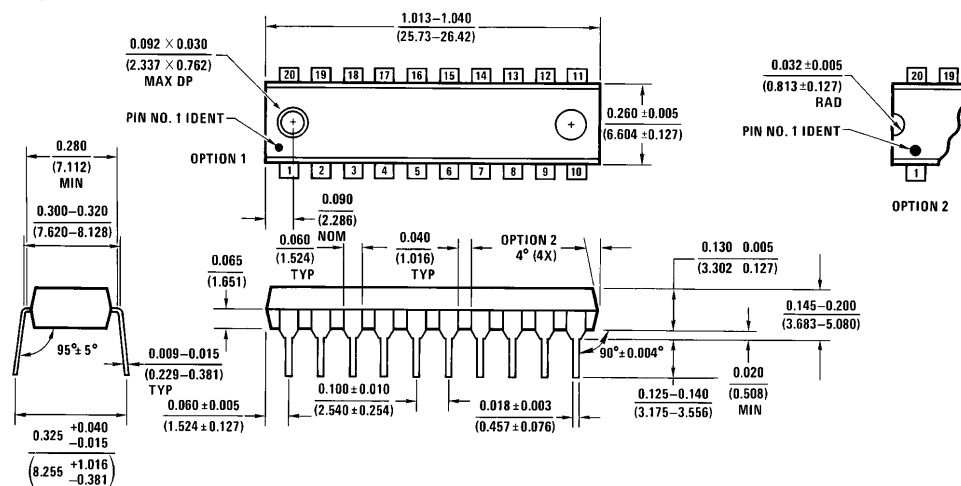
Physical Dimensions inches (millimeters)



Surface Mount Package
Order Number LM1972M
NS Package Number M20B

M20B (REV F)

Physical Dimensions inches (millimeters) (つづき)



N20A (REV G)

Dual-In-Line Plastic Package
Order Number LM1972N
NS Package Number N20A

生命維持装置への使用について

弊社の製品はナショナル セミコンダクター社の書面による許可なくしては、生命維持用の装置またはシステム内の重要な部品として使用することはできません。

1. 生命維持用の装置またはシステムとは (a) 体内に外科的に使用されることを意図されたもの、または (b) 生命を維持あるいは支持するものをいい、ラベルにより表示される使用法に従って適切に使用された場合に、これの不具合が使用者に身体的障害を与えると予想されるものをいいます。
2. 重要な部品とは、生命維持にかかわる装置またはシステム内のすべての部品をいい、これの不具合が生命維持用の装置またはシステムの不具合の原因となりそれらの安全性や機能に影響を及ぼすことが予想されるものをいいます。

ナショナル セミコンダクター ジャパン株式会社

本 社 / 〒 135-0042 東京都江東区木場 2-17-16 TEL.(03)5639-7300 <http://www.nsjk.co.jp/>

製品に関するお問い合わせはカスタマ・レスポンス・センタのフリーダイヤルまでご連絡ください。



0120-666-116



この紙は再生紙を使用しています

ご注意

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社（以下TIJといいます）及びTexas Instruments Incorporated（TIJの親会社、以下TIJないしTexas Instruments Incorporatedを総称してTIといいます）は、その製品及びサービスを任意に修正し、改善、改良、その他の変更をし、もしくは製品の製造中止またはサービスの提供を中止する権利を留保します。従いまして、お客様は、発注される前に、関連する最新の情報を取得して頂き、その情報が現在有効かつ完全なものであるかどうかご確認下さい。全ての製品は、お客様とTIJとの間に取り引契約が締結されている場合は、当該契約条件に基づき、また当該取引契約が締結されていない場合は、ご注文の受諾の際に提示されるTIJの標準販売契約約款に従って販売されます。

TIは、そのハードウェア製品が、TIの標準保証条件に従い販売時の仕様に対応した性能を有していること、またはお客様とTIJとの間で合意された保証条件に従い合意された仕様に対応した性能を有していることを保証します。検査およびその他の品質管理技法は、TIが当該保証を支援するのに必要とみなす範囲で行なわれております。各デバイスの全てのパラメーターに関する固有の検査は、政府がそれ等の実行を義務づけている場合を除き、必ずしも行なわれておりません。

TIは、製品のアプリケーションに関する支援もしくはお客様の製品の設計について責任を負うことはありません。TI製部品を使用しているお客様の製品及びそのアプリケーションについての責任はお客様にあります。TI製部品を使用したお客様の製品及びアプリケーションについて想定されうる危険を最小のものとするため、適切な設計上および操作上の安全対策は、必ずお客様にてお取り下さい。

TIは、TIの製品もしくはサービスが使用されている組み合わせ、機械装置、もしくは方法に関連しているTIの特許権、著作権、回路配置利用権、その他のTIの知的財産権に基づいて何らかのライセンスを許諾するということは明示的にも黙示的にも保証も表明もしておりません。TIが第三者の製品もしくはサービスについて情報を提供することは、TIが当該製品もしくはサービスを使用することについてライセンスを与えるとか、保証もしくは是認するということを意味しません。そのような情報を使用するには第三者の特許その他の知的財産権に基づき当該第三者からライセンスを得なければならない場合もあり、またTIの特許その他の知的財産権に基づきTIからライセンスを得て頂かなければならない場合もあります。

TIのデータ・ブックもしくはデータ・シートの中にある情報を複製することは、その情報に一切の変更を加えること無く、かつその情報と結び付けられた全ての保証、条件、制限及び通知と共に複製がなされる限りにおいて許されるものとします。当該情報に変更を加えて複製することは不正で誤認を生じさせる行為です。TIは、そのような変更された情報や複製については何の義務も責任も負いません。

TIの製品もしくはサービスについてTIにより示された数値、特性、条件その他のパラメーターと異なる、あるいは、それを超えてなされた説明で当該TI製品もしくはサービスを再販売することは、当該TI製品もしくはサービスに対する全ての明示的保証、及び何らかの黙示的保証を無効にし、かつ不正で誤認を生じさせる行為です。TIは、そのような説明については何の義務も責任もありません。

TIは、TIの製品が、安全でないことが致命的となる用途ないしアプリケーション（例えば、生命維持装置のように、TI製品に不良があった場合に、その不良により相当な確率で死傷等の重篤な事故が発生するようなもの）に使用されることを認めておりません。但し、お客様とTIの双方の権限有る役員が書面でそのような使用について明確に合意した場合は除きます。たとえTIがアプリケーションに関連した情報やサポートを提供したとしても、お客様は、そのようなアプリケーションの安全面及び規制面から見た諸問題を解決するために必要とされる専門的知識及び技術を持ち、かつ、お客様の製品について、またTI製品をそのような安全でないことが致命的となる用途に使用することについて、お客様が全ての法的責任、規制を遵守する責任、及び安全に関する要求事項を満足させる責任を負っていることを認め、かつそのことに同意します。さらに、もし万一、TIの製品がそのような安全でないことが致命的となる用途に使用されたことによって損害が発生し、TIないしその代表者がその損害を賠償した場合は、お客様がTIないしその代表者にその全額の補償をするものとします。

TI製品は、軍事的用途もしくは宇宙航空アプリケーションないし軍事的環境、航空宇宙環境にて使用されるようには設計もされていませんし、使用されることを意図されていません。但し、当該TI製品が、軍需対応グレード品、若しくは「強化プラスチック」製品としてTIが特別に指定した製品である場合は除きます。TIが軍需対応グレード品として指定した製品のみが軍需品の仕様書に合致いたします。お客様は、TIが軍需対応グレード品として指定していない製品を、軍事的用途もしくは軍事的環境下で使用することは、もっぱらお客様の危険負担においてなされるということ、及び、お客様がもっぱら責任をもって、そのような使用に関して必要とされる全ての法的要求事項及び規制上の要求事項を満足させなければならないことを認め、かつ同意します。

TI製品は、自動車用アプリケーションないし自動車の環境において使用されるようには設計されていませんし、また使用されることを意図されていません。但し、TIがISO/TS 16949の要求事項を満たしていると特別に指定したTI製品は除きます。お客様は、お客様が当該TI指定品以外のTI製品を自動車用アプリケーションに使用しても、TIは当該要求事項を満たしていなかったことについて、いかなる責任も負わないことを認め、かつ同意します。

Copyright © 2011, Texas Instruments Incorporated
日本語版 日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

弊社半導体製品の取り扱い・保管について

半導体製品は、取り扱い、保管・輸送環境、基板実装条件によっては、お客様での実装前後に破壊/劣化、または故障を起こすことがあります。

弊社半導体製品のお取り扱い、ご使用にあたっては下記の点を遵守して下さい。

1. 静電気

- 素手で半導体製品単体を触らないこと。どうしても触る必要がある場合は、リストストラップ等で人体からアースをとり、導電性手袋等をして取り扱うこと。
- 弊社出荷梱包単位（外装から取り出された内装及び個装）又は製品単品で取り扱いを行う場合は、接地された導電性のテーブル上で（導電性マットにアースをとったもの等）、アースをした作業者が行うこと。また、コンテナ等も、導電性のものを使うこと。
- マウンタやはんだ付け設備等、半導体の実装に関わる全ての装置類は、静電気の帯電を防止する措置を施すこと。
- 前記のリストストラップ・導電性手袋・テーブル表面及び実装装置類の接地等の静電気帯電防止措置は、常に管理されその機能が確認されていること。

2. 温・湿度環境

- 温度：0～40℃、相対湿度：40～85%で保管・輸送及び取り扱いを行うこと。（但し、結露しないこと。）

- 直射日光が当たる状態で保管・輸送しないこと。

3. 防湿梱包

- 防湿梱包品は、開封後は個別推奨保管環境及び期間に従い基板実装すること。

4. 機械的衝撃

- 梱包品（外装、内装、個装）及び製品単品を落下させたり、衝撃を与えないこと。

5. 熱衝撃

- はんだ付け時は、最低限260℃以上の高温状態に、10秒以上さらさないこと。（個別推奨条件がある時はそれに従うこと。）

6. 汚染

- はんだ付け性を損なう、又はアルミ配線腐食の原因となるような汚染物質（硫黄、塩素等ハロゲン）のある環境で保管・輸送しないこと。
- はんだ付け後は十分にフラックスの洗浄を行うこと。（不純物含有率が一定以下に保証された無洗浄タイプのフラックスは除く。）

以上